

國立中山大學半導體及重點科技研究學院

研究生提前畢業作業要點

114.6.23本校半導體學院113學年度第2學期第4次所院務聯合會議通過

115.6.16本校半導體學院114學年度第2學期第2次所院務聯合會議修正通過

一、為確立國立中山大學半導體及重點科技研究學院(以下簡稱本學院)研究生申請提前畢業之標準及程序，特訂定本要點。

二、本學院研究生(以下簡稱學生)申請提前畢業者，應依本學院公告之時間辦理。

三、學生欲申請提前畢業須符合所屬研究所「表現優異」之認定標準：

(一)先進半導體封測研究所本國生申請提前半年畢業須符合下列各標準：

1.學業表現：

(1)碩一成績在本所同年級本國生中排名前30%(名額採小數點無條件進位法計算)。

(2)碩二企業實習課程成績須在所屬企業同年級學生中排名前30%(名額採小數點無條件進位法計算)。惟企業協助培育學生在校人數若僅為一人時，則需滿足企業實習課程成績平均達84分以上(符合本校等第制 GPA 3.7以上)方得視為優良。

2.論文/專題技術報告研究表現：經指導教授(含共同指導教授)認定其研究進度與成果優良，得符合提前畢業標準。

(二)先進半導體封測研究所國際專班學生申請提前半年畢業須符合下列各標準：

1.學業表現：碩一成績在本所同年級國際專班學生中排名前30%(名額採小數點無條件進位法計算)。

2.論文研究表現：經指導教授(含共同指導教授)認定其研究進度與成果優良，得符合提前畢業標準。

(三)精密電子零組件研究所申請提前半年畢業須符合下列各標準：

1.學業表現：

(1)碩一成績在本所同年級學生中排名前30%(名額採小數點無條件進位法計算)。

(2)碩二企業實習課程成績須在所屬企業同年級學生中排名前30% (名額採小數點無條件進位法計算)。惟企業協助培育學生在校人數若僅為一人時，則需滿足企業實習課程成績平均達84分以上(符合本校等第制 GPA 3.7以上) 方得視為優良。

2.論文/專題技術報告研究表現：經指導教授(含共同指導教授)認定其研究進度與成果優良，得符合提前畢業標準。

(四)創新半導體製造研究所碩士班申請1.5年以內畢業須符合下列各標準：

1.學業表現：碩一成績在本所同年級學生中排名前30%(名額採小數點無條件進位法計算)。

2.論文研究表現：經指導教授(含共同指導教授)認定其研究進度與成果優良，得符合提前畢業標準。

(五)創新半導體製造研究所博士班申請3.5年以內畢業須符合下列各標準：

1.學業表現：博一成績在本所同年級學生中排名前30%(名額採小數點無條件進位法計算)。

2.論文研究表現：經指導教授(含共同指導教授)認定其研究進度與成果優良，得符合提前畢業標準。

四、申請程序：

(一)學生應於本學院公告之截止日前，檢具申請表及歷年成績單送交所屬研究所審核。

(二)經所屬研究所確認學業成績符合規定後，學生應送請指導教授(含共同指導教授)審核其研究進度與成果，並於收件截止日前將申請表及歷年成績單繳回所屬研究所。

(三)申請資料須經所屬研究所單位主管及院長核定。若學生指導教授(含共同指導教授)為該所所長或院長，則須由該主管之職務代理人核定。

五、通過提前畢業申請之學生，於預計畢業學期結束時，須符合所屬研究所學位考試相關規定，准予提前畢業。

六、本要點經本學院所院務聯合會議審議通過後實施，修正時亦同。